

特点

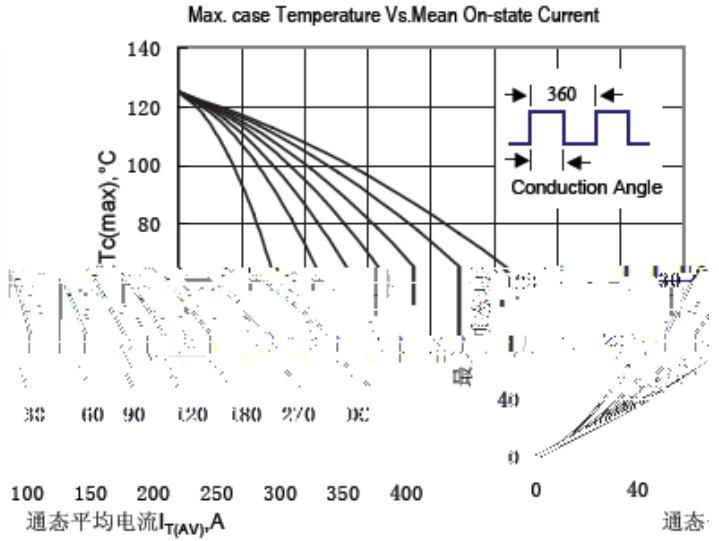
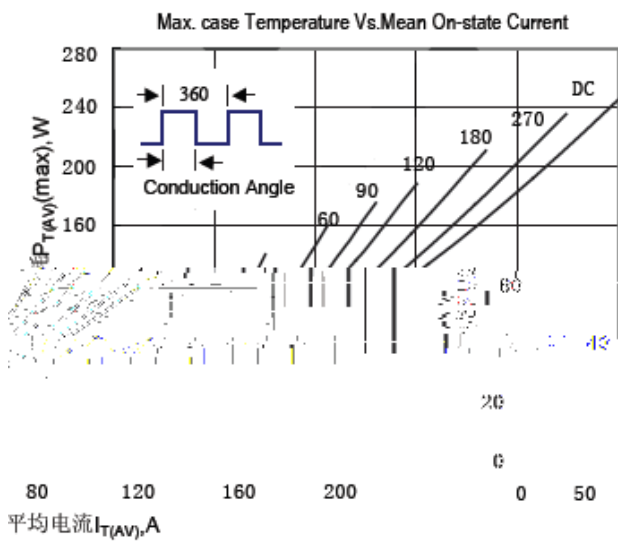
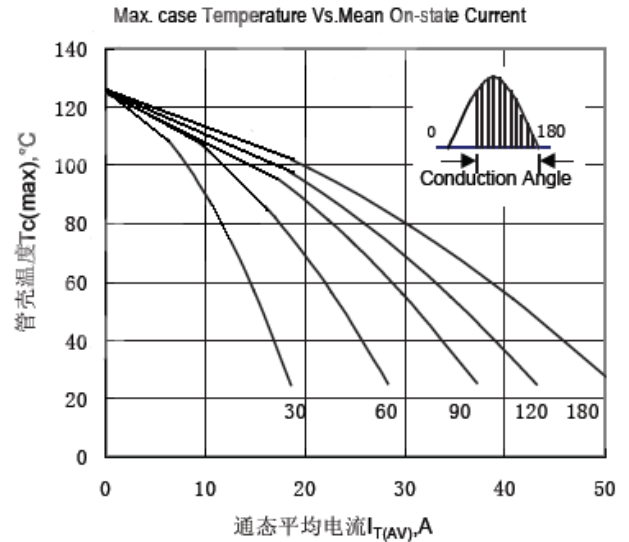
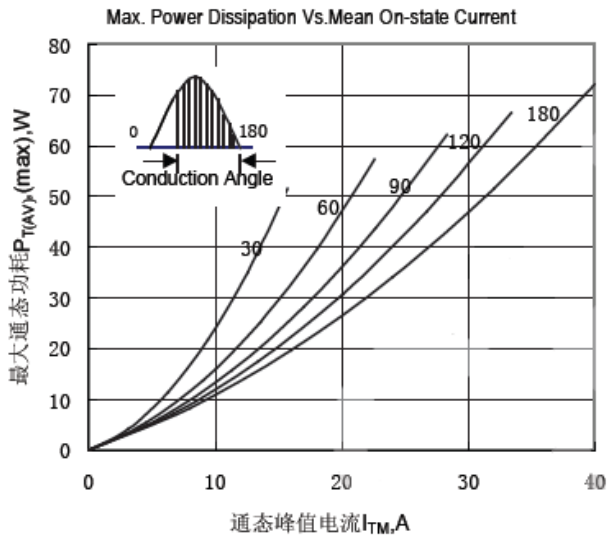
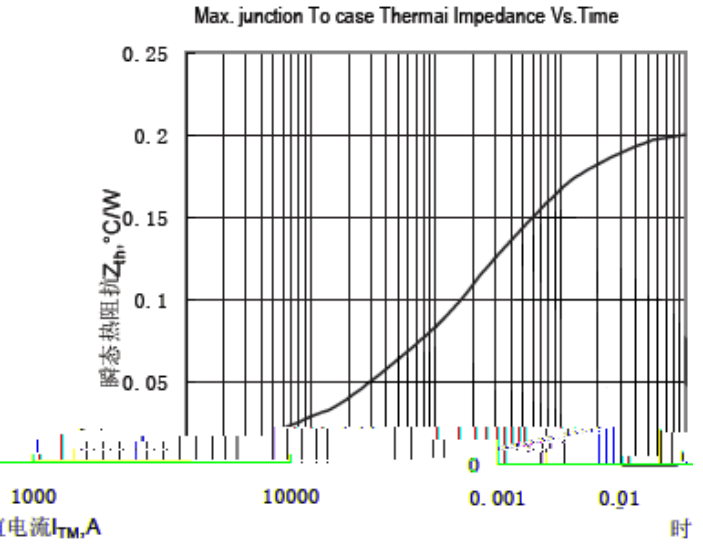
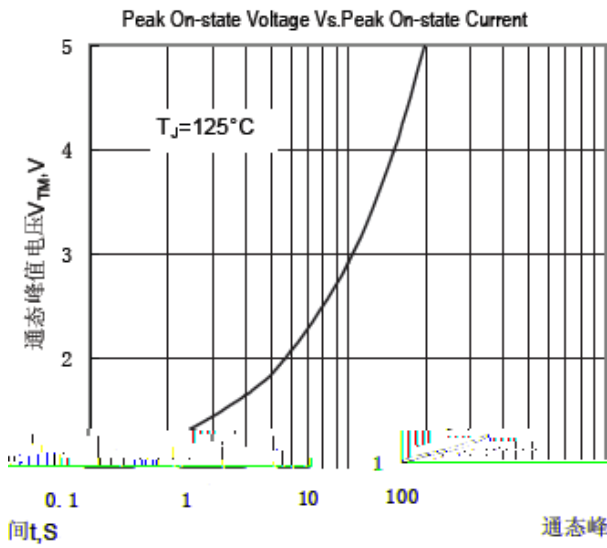
- 芯片与底板电气绝缘，交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 以下模块皆为强迫风冷，以上模块，风冷，水冷先用

$I_{T(AV)}$

典型应用

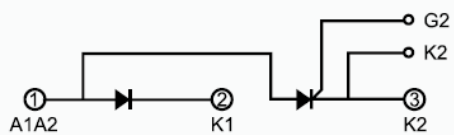
- 交直流电机控制，各种整流电源
- 工业加热控制，调光，无触发点开关
- 电机软起动，静止无功补偿
- 电焊机，变频器，电源，电池充放电

			$T_J()$				
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$		180 半波, 50HZ 双面散热, $T_C=85$	125			250	A
$I_{T(RMS)}$	方根		125			393	A
V_{DRM} V_{RRM}	断重复峰压 反向重复峰压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$ $V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125	500		2500	V
I_{DRM} I_{RRM}	断重复峰 反向重复峰	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$	125			40	mA
I_{TSM}	不重复浪涌	10ms 底宽, 半波	125			8.5	KA
I^2t	浪涌 方时间积	$V_R = 0.6V_{RRM}$					360
V_{TO}	门槛压		125			0.8	V
r_T	斜率阻						0.85
V_{TM}	峰压	$I_{TM} = 750A$	25			1.25	V
dv/dt	断压临界上升率	$V_{DM} = 0.67V_{DRM}$	125			800	V/us
di/dt	临界上升率	$I_{MT} = 52A$ 门极触发幅 $I_{GR} = 1.5A$ 门极上 \leq 升时间 $t_r \leq 0.5\mu s$	125			100	A/us
I_{GT}	门极触发	$V_A = 12V, I_A = 1A$	25	30		180	mA
V_{GT}	门极触发压			1.0		2.5	V
I_H	维持			20		150	mA
V_{GD}	门极不触发压	$V_{DM} = 0.67V_{DRM}$	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗 (至壳)	180 波, 面散热				0.120	/W
$R_{th(c-h)}$	热阻抗 (壳至散)	180 波, 面散热				0.04	/W
V_{iso}	绝缘压			2500			V
F_M	安装扭矩 (M5)				12		N-m
	安装扭矩 (M6)				6		N-m
T_{stq}	储存度			-40		125	
W_t	质量						g
Outline	外形						



线路图：

MFA(DT)



MFA(TD)

